РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АВТОМЕТРИЯ

Nº 3

1993

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 621.372.8:535

Н. Н. Каменев, В. И. Наливайко

(Новосибирск)

ДИФРАКЦИОННЫЕ ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ СХЕМ

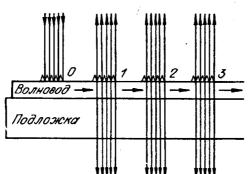
Продемонстрирована возможность создания на основе планарного волновода преобразователя монохроматического светового пучка в линейку параллельных световых пучков одинаковой интенсивности. Вводные и выводные дифракционные элементы преобразователя сформированы в тонких слоях A_2S_3 . Реализован случай слабого взаимодействия волноводной моды с выводными решетками. Приводятся технические характеристики экспериментального образца. Указаны возможные применения.

Для реализации трехмерных оптических связей в интегрально-оптических схемах актуально создание устройства, которое преобразует световой пучок, введенный в планарный волновод, в несколько пучков одинаковой интенсивности, выходящих из волновода ортогонально его поверхности. Такой демультиплексор может быть также одним из элементов оптического процессора с переменной логической структурой [1].

О разработке демультиплексора в планарном волноводе на основе решетчатых структур сообщено в [2—4]. В этих работах речь идет о расщеплении спектрально-уплотненного светового пучка по длинам волн в плоскости волновода. В нашем сообщении рассматривается трехмерный делитель монохроматического излучения.

Конструктивно предлагаемое устройство состоит из волновода, вводной и выводных дифракционных решеток (рис. 1). Применялись планарные волноводы, полученные диффузией ионов серебра в подложку из оксидного стекла и имевшие от одной до четырех мод [5].

Вводной и выводные элементы демультиплексора представляют собой



тонкие дифракционные решетки рельефного типа. Для их изготовления на пленки As₂S₃ толщиной 0,4—0,6 мкм, напыленные термическим испарением в вакууме, проецировалась интерференционная картина, создаваемая скрещенными пучками аргонового лазера. После экспонирования дифракционная эффективность (ДЭ) повышалась в процессе преобразования решетчатой структуры,

Рис. 1. Подложка с волноводом, вводной (0) и выводными (1, 2, 3, ...) решетками

обусловленной периодическим изменением показателя преломления, в рельефную решетку с помощью селективного травления поверхности [5]. Чтобы добиться асимметрии профиля штрихов и получить после травления решетку «с блеском», образец устанавливался в интерференционном поле так, что его поверхность составляла с одним из скрещивающихся пучков небольшой угол δ .

Тонкая дифракционная решетка выводит волноводную моду в виде двух световых пучков симметрично относительно плоскости волновода, как показано на рис. 1. Варьируя толщину напыленных слоев As_2S_3 и подбирая режим селективного травления, можно добиться необходимого соотношения интенсивностей световых пучков, выведенных в полупространство над волноводом и через подложку [5].

Период решетчатых структур d рассчитывался по известной формуле для дифракции на тонкой решетке. С учетом волноводного распространения дифрагированного света в среде с показателем преломления, равным 1,52, для волны длиной 0,6328 мкм при нормальном падении период составлял 0,42 мкм. Угол схождения скрещивающихся пучков 2Θ находился из соотношения

$$2\Theta + \delta = \arccos[\cos\delta - \lambda/d].$$

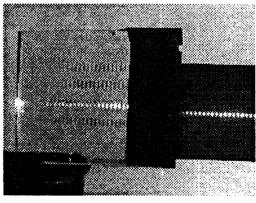
Чтобы получить решетки, для которых d=0,42 мкм, при использовании излучения с $\lambda=0,488$ мкм и $\delta=5^\circ$, между пучками устанавливался угол $2\Theta=95^\circ$, и в дальнейшем экспериментально уточнялся угол δ .

Для эффективной работы устройства вводная решетка должна иметь максимально возможную величину ДЭ. Теоретически эта величина для тонкой решетки синусоидального и прямоугольного профилей штрихов может составлять 33,9 и 40,4 % соответственно [6]. Для решеток «с блеском» (пилообразный профиль штрихов) эта величина может достигать 100 % [7]. В наших экспериментах величина ДЭ была порядка 50 %. Выводные решетки высокоэффективного демультиплексора для обеспечения одинаковой интенсивности всех выведенных световых пучков должны быть оптимизированы по величине ДЭ. При этом необходимо учитывать количество выводных элементов, их длину в направлении распространения волноводной моды и потери излучения в волноводе. Получение линейки требует последовательного изготовления каждой решетки с заранее рассчитанными параметрами и точного позиционирования образца при записи. Реализация такого варианта демультиплексора чрезвычайно трудоемкая задача.

При слабом взаимодействии волноводной моды с решеткой (ДЭ порядка 1%) одинаковая интенсивность вывода всеми элементами реализуется сравнительно просто — при одинаковой ДЭ всех выводных решеток. На рис. 2 приведены такой вариант демультиплексора и изображение на экране световых пучков, выведенных этим устройством в полупространство над волноводом на расстоянии 10 см. Луч Не—Nе-лазера падает на демультиплексор справа. На снимке виден трек волноводной моды, частично рассеиваемой на каждом выводном элементе и выходящей через торец волновода — яркое пятно слева. Для избавления от засветки рассеянным излучением при съемке часть

волновода и вводная решетка перекрыты полоской черной бумаги. Вводные элементы образца экспонировались индивидуально до получения максимальной величины ДЭ. В процессе экспозиции проводился неразрушающий контроль величины ДЭ излучением с длиной волны 0,6328 мкм. Выводные

Рис. 2. Экспериментальный образец интегрально-оптического демультиплексора и выведенные им пучки



решетки получались за один прием в пучках с плоскими волновыми фронтами. Для устранения влияния отраженных лучей от обратной стороны подложки в процессе записи решеток применялась стеклянная призма с иммерсионным слоем.

Вводные решетки образца имеют размеры 1×1 мм. Выводные элементы располагаются с периодом 0.7 мм и имеют ширину 0.2 мм. Неравномерность величины ДЭ для 16 выводных элементов не превышает 5 %. Энергия, выведенная в полупространство над волноводом, составляет 16 % от энергии волноводной моды. Соотношение интенсивностей, выведенных в полупространство над волноводом и через подложку, равно 5:1.

Необходимо отметить, что пленки As₂S₃ обладают уникальным сочетанием волноводных свойств с возможностью записи в их объеме голографических решеток [8]. Поэтому применение этих покрытий даст возможность в дальнейшем упростить конструкцию демультиплексора, сделав его однослойным. Кроме того, формирование в объеме таких слоев решетчатых структур брэговского типа позволит, сохранив планарность конструкции, увеличить эффективность устройства и упростить технологию его изготовления, исключив трудно контролируемый процесс травления поверхности.

Продемонстрирована возможность создания в планарном волноводе преобразователя монохроматического светового пучка в линейку световых пучков. Такой делитель может быть полезен при разработке трехмерных интегрально-оптических схем. Набор подобных демультиплексоров в сочетании с линейкой полупроводниковых лазеров позволит изготовить матричный источник управляемых световых пучков, который может быть применен для реализации принципа ассоциативной обработки информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Басов Н. Г., Волчков В. Г., Компанец И. Н. и др. Способы реализации оптического процессора с переменными операторами // Квантовая электрон.—1978.—5, № 3.
- Livens A. C., Katie A., Yard A. et al. Chirped-grating demultiplexers in dielectric wave guides // Appl. Phys. Lett.—1977.—30, N 10.—P. 519.
- Быковский Ю. А., Мочалкина О. Р., Смирнов В. Л. и др. Интегрально-оптический демультипликатор с матрицей волноводных фотоприемников // Письма в ЖТФ.—1978.—4, вып. 9.
- Rice R. R., Zeno J. D., Brian D. A. et al. Guided wave optical systems and devices II // Proc. SPIE.—1979.—176.—P. 133.
- Балагуров А. Я., Доценко В. И., Морозов В. Н. и др. Волноводные голограммы двумерных объектов // Автометрия.—1986.—№ 2.
- 6. Кольер Р., Беркхарт К., Лин Л. Оптическая голография. М.: Мир, 1973.
- Hutley M. C. Blazed interference diffraction gratings for the ultra-violet // Opt. Acta.—1975.—22, N 1.—P. 1.
- 8. Андриеш А. М., Быковский Ю. А., Коломейко Э. П. и др. Волноводные структуры и функциональные элементы интегрально-оптических схем на основе объемных голографических решеток в тонких пленках As₂S₃ // Квантовая электрон.—1977.—4, № 3.

Поступило в редакцию 9 марта 1993 г.